


	<h2 style="color: red;">FDP2D3N10C</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP2D3N10C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 222A TO220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDP2D3N10C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDP2D3N10C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 222A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 700µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11180pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	152nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 222A (Tc) 214W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	222A (Tc)

FDP2D3N10C Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP2D3N10C-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP2D3N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDP2D3N10C E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP2710-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A TO-220</p>	 <p>FDP3205 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 100A TO-220</p>	 <p>FDP34N33 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>	 <p>FDP26N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 26A TO-220</p>
 <p>FDP2710_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDP2710_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP2710 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A TO-220</p>	 <p>FDP33N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-220</p>	 <p>FDP33N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP2D3N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP2D3N10C Datenblatt	FDP2D3N10C-Datenblätter	FDP2D3N10C PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP2D3N10C
FDP2D3N10C Electronic	FDP2D3N10C-Komponenten	FDP2D3N10C-Verteiler	FDP2D3N10C-Bild	FDP2D3N10C-Teil
FDP2D3N10C Preis	FDP2D3N10C Hersteller	FDP2D3N10C Bild	FDP2D3N10C Aktie	FDP2D3N10C Inventar
FDP2D3N10C Neu	FDP2D3N10C Original	FDP2D3N10C garantiert	FDP2D3N10C RFQ	FDP2D3N10C Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited